Procédés et catégories de procédés	Gaz *i*										
	CF_4	C_2F_6	CHF_3	CH_2F_2	C_3F_8	c-C_4F_8	NF_3	SF_6	C_4F_6	C_5F_8	C_4F_8O
MODELAGE DES CONTOURS/GRAVURE											
Gravure à l'Oxyde											
$1-U_I$	0,2-0,8	0,2-0,7	0,2-0,7	0,02-0,3	S. O.	0,1-0,3	0,1-0,4	0,1-0,4	0,05-0,5	0,05-0,3	S. O.
P_{CF4}	S. O.	0,05-0,5	0,01-0,8	0,05-0,1	S. O.	0,01-0,3	S. O.	S. O.	0,02-0,4	0,02-0,4	S. O.
P_{C2F6}	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	0,01-0,3	S. O.	S. O.	0,02-0,3	0,02-0,3	S. O.
P_{C3F8}	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.
Gravure du Nitrure											
$1-U_I$	0,2-0,8	0,2-0,7	0,1-0,7	0,02-0,3	S. O.	0,05-0,3	0,1-0,4	0,1-0,4	0,05-0,2	0,05-0,3	S. O.
P_{CF4}	S. O.	0,05-0,5	0,01-0,8	0,05-0,1	S. O.	0,02-0,3	S. O.	S. O.	0,02-0,4	0,02-0,4	S. O.
P_{C2F6}	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	0,005-0,3	S. O.	S. O.	0,02-0,3	0,02-0,3	S. O.
P_{C3F8}	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.
Gravure du Silicium											
$1-U_I$	0,2-0,8	0,2-0,7	0,2-0,7	0,02-0,3	S. O.	0,1-0,3	0,1-0,4	0,1-0,4	0,05-0,2	0,05-0,3	S. O.
P_{CF4}	S. O.	0,05-0,5	0,01-0,8	0,05-0,1	S. O.	0,01-0,3	S. O.	S. O.	0,02-0,4	0,02-0,4	S. O.
P_{C2F6}	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	0,01-0,3	S. O.	S. O.	0,02-0,3	0,02-0,3	S. O.
P_{C3F8}	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.

Gravure du Métal											
$1-U_I$	0,2-0,8	0,2-0,7	0,2-0,7	0,02-0,3	S. O.	0,1-0,3	0,1-0,4	0,1-0,4	0,05-0,2	0,05-0,3	S. O.
P_{CF4}	S. O.	0,05-0,5	0,01-0,8	0,05-0,1	S. O.	0,01-0,3	S. O.	S. O.	0,02-0,4	0,02-0,4	S. O.
P_{C2F6}	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	0,01-0,3	S. O.	S. O.	0,02-0,3	0,02-0,3	S. O.
P_{C3F8}	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.
NETTOYAGE DES CHAMBRES											
Nettoyage de Système au plasma interne											
$1-U_I$	0.8-0.95	0.4-0.8	S. O.	S. O.	0.2-0.6	005-0.3	0.05-0.2	S. O.	S. O.	0.05-0.2	0.05-0.2
P_{CF4}	S. O.	0.05-0.2	S. O.	S. O.	0.05-0.2	0.05-0.2	0.05-0.1	S. O.	S. O.	0.05-0.2	0.05-0.2
P_{C2F6}	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.
P_{C3F8}	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	0.02-0.08
Nettoyage de Système au plasma séparé											
$1-U_I$	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	0,005-0,03	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.
P_{CF4}	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	0,0001-0,2	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.
P_{C2F6}	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.
P_{C3F8}	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.
Nettoyage de Système de chaleur interne											
$1-U_I$	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.
P_{CF4}	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.
P_{C2F6}	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.
P_{C3F8}	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.

NETTOYAGE DES TRANCHES											
Nettoyage de chant											
$1-U_l$	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.
P_{CF4}	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.
P_{C2F6}	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.
P_{C3F8}	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.
Calcination											
$1-U_l$	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.
P_{CF4}	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.
P_{C2F6}	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.
P_{C3F8}	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.